

КП744А-Г

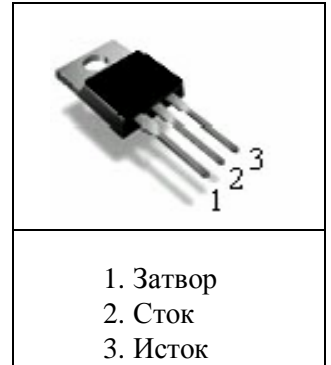
**МОЩНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ N-КАНАЛЬНЫЙ
МОП ТРАНЗИСТОР**

АДБК 432140.679 ТУ

КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ, ОБОГАЩЕНИЕМ N-КАНАЛА И ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНОСМЕЩЕННЫМ ДИОДОМ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВХОДОМ, В РЕГУЛЯТОРАХ, СТАБИЛИЗАТОРАХ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ С НЕПРЕРЫВНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И ДРУГОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ.

* Зарубежный аналог - **IRF520, 521, 522**

* Изготавливается в корпусе КТ-28 (ТО-220).



ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Предельные значения			
			А	Б	В	Г
Напряжение сток-исток	Uси max	В	100	80	100	100
Напряжение затвор-исток	Uзи max	В	±20	±20	±20	±10
Постоянный ток стока	Iс max	А	9.2	9.2	8.0	9.2
Импульсный ток стока	Iс и max	А	37	37	32	36
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	60	60	60	60
Прямой ток диода	Iпр. max	А	9.2	9.2	8.0	9.2
Температура перехода	Tпер	°С	175	175	175	175

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измерения	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение КП744А,Б,В П744Г	Uзи пор	В	Iс=250мкА, Uзи=Uси	2.0 1.0	4.0 2.0
Ток стока КП744А,Б КП744В КП744Г	Iс	А	ti ≤300мкс. Q ≥50 Uси=3.0В, Uзи=10В Uси=3.3В, Uзи=10В Uси=4.0В, Uзи=5В	9.2 8.0 9.2	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии КП744А,Б КП744В КП744Г КП744Г	Rси отк	Ом	ti ≤300мкс. Q ≥50 Iс=5.5А, Uзи=10В Iс=5.5А, Uзи=10В Iс=4.6А, Uзи=4В Iс=5.5А, Uзи=5В		0.27 0.36 0.38 0.27
Остаточный ток стока	Iс ост	мкА	Uси=Uси max, Uзи=0		250
Ток утечки затвора КП744Г	Iз уг	нА	Uси=0, Uзи=±20В Uси=0, Uзи=±10В	-100 -100	+100 +100
Крутизна ВАХ КП744Г	S	А/В	ti ≤300мкс. Q ≥50 Uси=25В, Iс=5.5А	2.7 3.2	
Прямое напряжение диода КП744А,Б КП744В КП744Г	Uпр	В	ti ≤300мкс. Q ≥50 Iс=-9.2А, Uзи=0 Iс=-8.0А, Uзи=0 Iс=-9.2А, Uзи=0		1.8 1.8 2.5
Время включения/выключения КП744Г	* твкл/ твыкл	нс	ti ≤300мкс. Q ≥50, Uси=50В, Iс=Iс max Rг=18 Ом, Rс=5.2 Ом Rг=9Ом		58/57 90/80
Тепл.сопрот. переход-корпус	* Rт п-к	°С/Вт			2.5
Входная емкость КП744Г	* C11и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		470 650
Выходная емкость КП744Г	* C22и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		195 200
Проходная емкость	* C12и	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		70

* Справочные параметры

220108, г.Минск, ул. Корженевского,16 УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>